| **Поз. обоз-**  **начение** | **Наименование** | **Кол.** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсаторы |  |  |
|  | GRM: ЧИП-0603, ЧИП-1206, ф. Murata, Япония; Танталовые ЧИП-А: ф. AVX, США |  |  |
| C1 | GRM1206-U2J-630В-2,2нФ±5% | 1 |  |
| C2 | GRM0805-X7R-50В-1мкФ±10% | 1 |  |
| C3, C5, C8-C14, C18, C19, C27-C29 | GRM0603-X7R-50В-0,1мкФ±10% | 14 |  |
| C4 | GRM0603-X7R-50В-1нФ±10% | 1 |  |
| C6 | ЧИП-A-16В-10мкФ±20% | 1 |  |
| C7 | К10-79-10В-10нФ±20% Н30 АЖЯР.673511.004 ТУ | 1 | \*GRM0603-X7R-50В-10нФ±10% |
| C15 | 597D107X0035F2T, ф. Vishay, США | 2 |  |
| C17 | EEFCX1E220R, ф. Panasonik, Япония | 1 |  |
| C20-C24 | GRM1206-X7R-50В-1мкФ±10 | 5 |  |
| C25, C26 | GRM0603-X7R-50В-100пФ±10% | 2 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DA1 | AD820BRZ, ф. Analog Devices, США | 1 | AD822ARM |
| DA2 | AD823ARZ, ф. Analog Devices, США | 1 | AD822ARM |
| DD1 | L78L05ABUTR, ф. ST Microelectronics, США | 1 | LT3080EDD-1 |
| DD2 | STM32F051K6T6, ф. ST Microelectronics, США | 1 |  |
| DD3 | MAX13430EEUB+, ф. Maxim Integrated, США | 1 | ADM3485EAR |
| DD4 | L78L33ABUTR, ф. ST Microelectronics, США | 1 | LT3080EDD-1 |
| DD5 | HEF4081BT, ф. NXP Semiconductors, Нидерланды | 1 | SN74LVC125APW |
|  |  |  |  |
| F1 | Предохранитель, MF-LSMF185/33X-2, ф. Bourns, США | 1 |  |

| **Поз. обоз-**  **начение** | **Наименование** | **Кол.** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| K1 | Реле, G3VM-601G1, ф. Omron, Япония | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  | Катушки индуктивности |  |  |
| L1 | Чип индуктивность 0805-220мкГн±20%, ф. Vishay, США | 1 |  |
| L2 | IHLP2020BZER100M11, ф. Vishay, США | 1 |  |
| L3 | IHLP6767DZER220M11, ф. Vishay, США | 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
|  | CR ЧИП ф. Bourns, США |  |  |
| R1, R9 | Р1-12-0,062-1МОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 2 | \*CR-0603-1МОм±1% |
| R2, R4 | Р1-12-0,062-330Ом±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 2 | \*CR-0603-330Ом±1% |
| R3 | Р1-12-0,125-100кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-0805-100кОм±1% |
| R5 | Р1-12-0,062-200Ом±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-0603-200Ом±1% |
| R6 | Резистор 3223W-1-2МОм, ф. Bourns, США | 1 |  |
| R7 | CR-0805-2,7МОм±1% | 1 |  |
| R8 | CR-0805-3,3МОм±1% | 1 |  |
| R10 | Р1-12-0,25-120Ом±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-1206-120Ом±1% |
| R11 | Р1-12-0,062-15кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-0603-15кОм±1% |
| R12 | Р1-12-0,062-4,3кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-0603-4,3кОм±1% |
| R13 | Р1-12-0,062-100кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-0603-100кОм±1% |
| R14, R19 | Р1-12-0,062-20кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 2 | \*CR-0603-20кОм±1% |
| R15 | Р1-12-0,062-2кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 1 | \*CR-0603-2кОм±1% |
| R16, R26, R31, R37 | Р1-12-0,062-10кОм±5% АЛЯР.434110.005 ТУ | 4 | \*CR-0603-10кОм±1% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Лист регистрации изменений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номер листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц)  в документе | Номер  документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| измененных | замененных | новых | аннулированных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |